

# 2SC853

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用 / Audio Frequency Amplifier

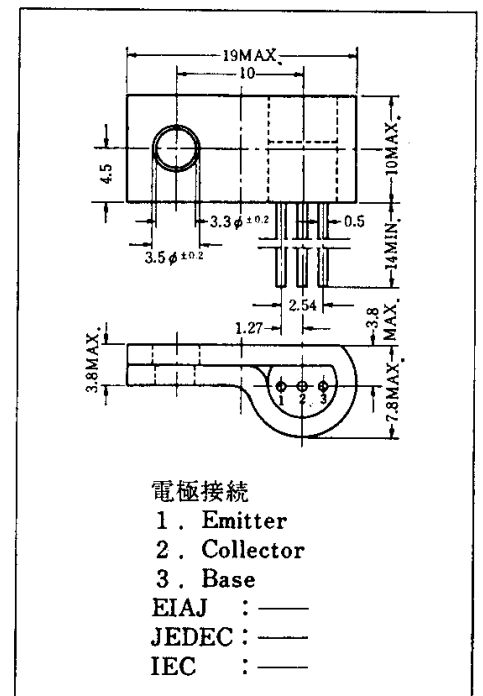
## 特徴 / FEATURES

- ・主要特性が PNP 形の 2SA545 とほとんど同じであり、2SA545 とコンプリメンタリで使用可能です。
- ・20~25W クラスアンプのドライバとして最適です。
- ・耐圧が高い。  
High voltage,  $V_{CEO} = 60V$ .
- Complementary to PNP 2SA545.

## 絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	70	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	60	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5.0	V
コレクタ電流	$I_C$	200	mA
全損失	$P_T$	400	mW
ジャンクション温度	$T_J$	125	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+125	$^\circ C$

## 外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



## 電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 60V, I_E = 0$			0.1	$\mu A$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 3.0V, I_C = 0$			0.1	$\mu A$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 50mA^*$	50	80	232	
直流電流増幅率	$h_{FE2}$	$V_{CE} = 2.0V, I_C = 150mA^*$	30	70		
直流ベース電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 10V, I_C = 10mA$	0.60	0.65	0.90	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 150mA, I_B = 15mA^*$		0.15	0.50	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 150mA, I_B = 15mA^*$		0.83	1.20	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = 10V, I_E = -10mA$		150		MHz

\* パルス測定 / pulsed

$h_{FE}$  区分 /  $h_{FE}$  Classification

$h_{FE1}$  / M : 50~94    L : 80~150    K : 125~232